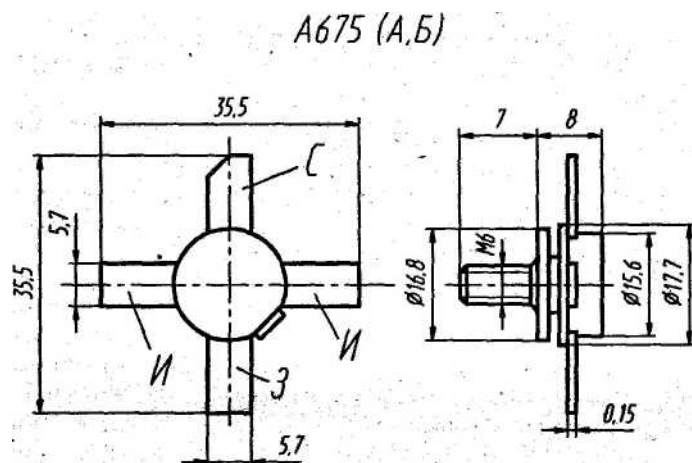


А675А, А675Б

Транзисторы кремниевые полевые эпитаксиально-планарные с изолированным затвором и индуцированным каналом n-типа генераторные. Предназначены для применения в усилителях мощности и генераторах с рабочей частотой до 400 МГц в непрерывном и импульсном режимах при напряжении питания 45 В, а также в переключающих схемах. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 12 г. Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.



Электрические параметры

Выходная мощность на $f = 400$ МГц при $U_{си} = 45$ В, не менее:

А675А, $P_{вх} = 50$ Вт 100 Вт

А675Б, $P_{вх} = 35$ Вт 70 Вт

Крутизна характеристики при $U_{си} = 26$ В, $I_c = 3$ А, не менее 1 А/В

Начальный ток стока при $U_{си} = 20$ В, $U_{зи} = 0$, не более 300 мА

Остаточный ток стока при $U_{си} = 50$ В, $U_{зи} = -10$ В, не более 200 мА

Ток стока при $U_{си} = 20$ В, $U_{зи} = 20$ В, не менее:

А675А 14 А

А675Б, 10 А

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток—исток 50 В

Напряжение сток—исток в динамическом режиме 65 В

Постоянное напряжение затвор—исток 20 В

Постоянное напряжение затвор—сток 60 В

Напряжение затвор—сток в динамическом режиме 75 В

Потенциал статического электричества 200 В

Постоянная рассеиваемая мощность¹:

$T_k = -60...+25$ °С 100 Вт

$T_k = +125$ °С 20 Вт

Температура окружающей среды $-60... T_k = +125$ °С

¹ При $T_k = +25...+125$ °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность снижается линейно.

Крепление транзистора к панели следует осуществлять при помощи гайки, при этом корпус транзистора должен плотно прилегать к теплоотводу с шероховатостью поверхности не более 0,8 мкм и неплоскостностью не более 0,02 мм. Крутящий момент на монтажный винт при креплении 0,25 кгсм.

Допускается обрезка полосковых выводов на расстоянии 4 мм от корпуса с сохранением среза на стоковом выводе. Минимальное расстояние места пайки выводов от корпуса 3 мм, температура пайки не выше +260 °С, время пайки не более 3 с. Допускается сварка выводов на расстоянии не менее 0,5 мм от корпуса, при этом температура корпуса не должна превышать +150 °С.

При использовании транзисторов в усилителях мощности с напряжением питания не более 30 В допускается работа на рассогласованную нагрузку при сохранении значения напряжения и рассеиваемой мощности в пределах максимально допустимых.